PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-335574

(43)Date of publication of application: 18.12.1998

(51)Int.CI.

H01L 25/04 H01L 25/18

(21)Application number: 09-156057

(71)Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

30.05.1997

(72)Inventor:

KAWAMURA TOMOAKI

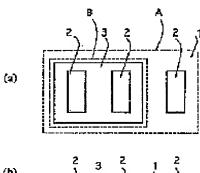
YAMANAKA NAOAKI KAIZU KATSUMI HARADA AKIO

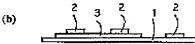
(54) ELECTRONIC CIRCUIT DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the production yield of MCM substrates by mounting sub-modules in multichip modules(MCM); each sub-module mounting semiconductor integrated circuits on a sub-substrate.

SOLUTION: On a multichip module MCM substrate 1 sub-substrates 3 are mounted in addition to IC2 and other IC2 is mounted on the sub-substrate 3 to form a sub-module B at part of this sub-structure 3. This allows part of wirings which were always necessary on the MCM substrate 1 to be moved o the substrate 3, resulting in less no. of wirings on the substrate 1 and improved production yield of this substrate 1. Sub-module external connection terminals for connecting the sub-module B on the sub-substrate 3 to externals or IC connection terminals for connecting the IC2 on the sub-substrate 3 thereto may be formed.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25,12,2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

24,06,2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特群庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公阴番号

特開平10-335574

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl.6

H01L 25/04

25/18

識別記号

FΙ

H01L 25/04

Z

審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全 7 頁)

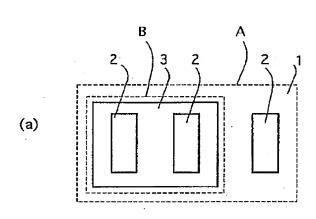
(21)出願番号	特願平9-156057	(71) 出願人 000004226		
		日本電信電話株式会社		
(22)出顧日	平成9年(1997)5月30日	東京都新宿区西新宿三丁目19番2号		
		(72)発明者 川村 智明		
		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本		
		電信電話株式会社内		
		(72) 発明者 山中 直明		
		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本		
		電信電話株式会社内		
		(72)発明者 海津 勝美		
		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本		
		電信電話株式会社内		
		(74)代理人 弁理士 長尾 常明		
		最終頁に統く		
		20,737,12,00		

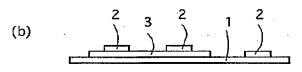
(54) 【発明の名称】 電子回路装置

(57)【要約】

【課題】 MCM基板又はMCMケースの製造歩留り を向上させる。

【解決手段】 MCM基板1上に搭載されるマルチチッ プモジュールA内に、IC2をサブ基板3に搭載したサ ブモジュールBを搭載する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】MCM基仮又はMCMケース上に2以上の 半導体集積回路素子等を搭載したマルチチップモジュー ルを有する電子回路装置において、

サブ基板上に2以上の半導体集積回路素子等を搭載して なるサブモジュールを、前記マルチチップモジュール内 に搭載したことを特徴とする電子回路装置。

【請求項2】前記サブ基板に、前記サブモジュールをサ ブモジュール外部と接続するためのサブモジュール外部 接続端子と、前記サブモジュール内に搭載される半導体 10 集積回路素子等を前記サブ基板に接続するためのIC接 続端子とを設けたことを特徴とする請求項1に記載の電 子回路装置。

【請求項3】前記サブ基板に、前記サブモジュール外部 接続端子と前記IC接続端子とを接続するための配線を 設けたことを特徴とする請求項2 に記載の電子回路装 涩。

【請求項4】前記サブ基板に、前記 I C接続端子の相互 間を接続する配線を設けたことを特徴とする請求項2又 は3に記載の電子回路装置。

【請求項5】前記サブモジュール内の半導体集積回路素 子等が、前記IC接続端子に接続されることを特徴とす る請求項2乃至4に記載の電子回路装置。

【請求項6】前記サブモジュール内の半導体集積回路素 子等が、前記サブ基板を介して、前記サブモジュール内 の他の半導体回路素子等に接続されることを特徴とする 請求項2乃至5に記載の電子回路装置。

【請求項7】前記サブモジュール外部接続端子が、マル チチップモジュール外部接続端子、前記サブモジュール 外の半導体回路素子等、あるいは他のサブモジュールに 30 なるという問題があった。 接続されることを特徴とする請求2乃至6に記載の電子 回路装置。

【請求項8】前記サブモジュール内の半導体回路素子等 が、ボンディングワイヤ、TAB用リード、リードフレ ーム、あるいはフリップチップ用リード等の信号伝送媒 体を介して、サブ基板上のIC接続端子に接続されるこ とを特徴とする請求項2乃至7に記載の電子回路装置。

【請求項9】前記サブモジュール内の半導体回路素子等 の相互間が、ボンディングワイヤ、TAB用リード、リ ードフレーム、あるいはフリップチップ用リード等の信 40 号伝送媒体を介して、直接的に接続されることを特徴と する請求項2乃至7に記載の電子回路装置。

【請求項10】前記サブモジュール外部接続端子が、ボ ンディングワイヤ、TAB用リード、リードフレーム、 あるいはBGA用リード等の信号伝送媒体、およびMC M基板又はMCMケース上の信号伝送媒体を介して、前 記マルチチップモジュール外部接続端子、サブモジュー ル外の半導体集積回路素子等、あるいは他のサブモジュ ールに接続されることを特徴とする請求項2乃至乃至9 に記載の電子回路装置。

【請求項11】前記サブモジュール外部接続端子が、ボ ンディングワイヤ、TAB用リード、リードフレーム、 あるいはBGA用リード等の信号伝送媒体を介して、サ ブモジュール外の半導体集員回路素子等、あるいは他の サブモジュールに直接的に接続されることを特徴とする 請求項2乃至乃至9に記載の電子回路装置。

【請求項12】前記サブモジュール内に、別のサブモジ ュールを内蔵させたことを特徴とする請求項1乃至11 に記載の電子回路装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マルチチップモジ ュール (以下、「MCM」と呼ぶこともある。) からな る電子回路装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から、半導体集積回路素子(以下、 「IC」と呼ぶ。) を高密度に実装する技術として、図 14に示すように、マルチチップモジュール基板又はマ ルチチップモジュールケースの一部(以下では、「MC 20 M基板」と呼ぶ。) 1の上に、複数の IC2を一体化し てマルチチップモジュールAを構成するMCM技術が利 用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、このMCM 技術では、1枚のMCM基板1の上にすべてのIC2が 直接搭載されていたので、マルチチップモジュールA内 に搭載するIC2の数が増えると、IC2の搭載用のM CM基板1の形状が大きくなり、またMCM基板に必要 となる配線数が増大し、MCM基板の製造歩留りが悪く

【0004】本発明はこのような点に鑑みてなされたも ので、その目的は、このMCM基板の製造歩留りを向上 させることである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に第1の本発明は、MCM基板又はMCMケース上に2 以上の半導体集積回路素子等を搭載したマルチチップモ ジュールを有する電子回路装置において、サブ基板上に 2以上の半導体集積回路素子等を搭載してなるサブモジ ュールを、前記マルチチップモジュール内に搭載して構 成した。第2の発明は、第1の発明において、前記サブ 基板に、前記サブモジュールをサブモジュール外部と接 続するためのサブモジュール外部接続端子と、前記サブ モジュール内に搭載される半導体集積回路素子等を前記 サブ基板に接続するためのIC接続端子とを設けて構成 した。第3の発明は、第2の発明において、前記サブ基 板に、前記サブモジュール外部接続端子と前記IC接続 端子とを接続するための配線を設けて構成した。第4の 発明は、第2又は第3の発明において、前記サブ基板

50 に、前記 I C接続端子の相互間を接続する配線を設けて

構成した。第5の発明は、第2乃至第4の発明におい て、前記サブモジュール内の半導体集積回路素子等が、 前記 I C接続端子に接続されるよう構成した。第6の発 明は、第2乃至第5の発明において、前記サブモジュー ル内の半導体集積回路素子等が、前記サブ基板を介し て、前記サブモジュール内の他の半導体回路素子等に接 続されるよう構成した。第7の発明は、第2乃至第6の 発明において、前記サブモジュール外部接続端子が、マ ルチチップモジュール外部接続端子、前記サブモジュー ル外の半導体回路素子等、あるいは他のサブモジュール 10 に接続されるよう構成した。第8の発明は、第2乃至第 7の発明において、前記サブモジュール内の半導体回路 素子等が、ボンディングワイヤ、TAB用リード、リー ドフレーム、あるいはフリップチップ用リード等の信号 伝送媒体を介して、サブ基板上のIC接続端子に接続さ れるよう構成した。第9の発明は、第2乃至第8の発明 において、前記サブモジュール内の半導体回路素子等の 相互間が、ボンディングワイヤ、TAB用リード、リー ドフレーム、あるいはフリップチップ用リード等の信号 伝送媒体を介して、直接的に接続されるよう構成した。 第10の発明は、第2乃至第9の発明において、前記サ ブモジュール外部接続端子が、ボンディングワイヤ、T AB用リード、リードフレーム、あるいはBGA用リー ド等の信号伝送媒体、およびMCM基板又はMCMケー ス上の信号伝送媒体を介して、前記マルチチップモジュ ール外部接続端子、サブモジュール外の半導体集積回路 素子等、あるいは他のサブモジュールに接続されるよう に構成した。第11の発明は、第2乃至第10の発明に おいて、前記サブモジュール外部接続端子が、ボンディ ングワイヤ、TAB用リード、リードフレーム、あるい はBGA用リード等の信号伝送媒体を介して、サブモジ ュール外の半導体集積回路素子等、あるいは他のサブモ ジュールに直接的に接続されるるように構成した。第1

[0006]

した。

【発明の実施の形態】

[第1の実施の形態] 図1は本発明の第1の実施の形態 の電子回路装置の説明図で、(a)は平面図、(b)は 40 正面図である。図1において、前記した図14で説明し たものと同一のものには同一の符号を付している。こと では、MCM基板1の上に、IC2の外にサブ基板3を 搭載して、このサブ基板3上に別のIC2を搭載するこ とにより、このサブ基板3の部分にサブモジュールBを 構成している。

2の発明は、第2乃至第11の発明において、前記サブ

モジュール内に、別のサブモジュールを内蔵させて構成

【0007】このように構成することにより、従来MC M基板1上に必ず必要であった配線の一部をサブ基板3 上に移動させることができるため、MCM基板1の配線 数が減少し、そのMCM基板1の製造歩留りが向上す

る。

【0008】図2はその第1の応用例を示す図である。 ここでは、サブ基板3上に、サブモジュールBと外部と の接続を行うためのサブモジュール外部接続端子4、サ ブ基仮3上の102とサブ基板3を接続するための10 接続端子5を形成している。このように端子4、5を設 けることにより、その間をサブ基板3上の配線6で接続 して、サブ基板3上の各IC2をサブモジュールBの外 部と接続することが可能となる。

【0009】図3は第2の応用例を示す図である。ここ では、サブ基板3上において、 I C接続端子5の一部の 相互間を、サブ基板3上の配線7で接続することによ り、サブ基板3上の複数のIC2を直接接続している。 この構成により、サブ基板3上のIC2の間を短距離で 接続することができるばかりか、IC接続端子5のすべ てをサブモジュール外部接続端子4に接続する必要はな くなる。

【0010】図4は第3の応用例を示す図である。ここ では、サブモジュール外部接続端子4をMCM外部接続 20 端子8 (符号のみ示す。) に接続すると共に、サブモジ ュールBの外の1C2にも接続している。このような構 成により、サブモジュール内のIC2はマルチチップモ ジュールAの外部のICや、マルチチップモジュールA の内部で且つサブモジュールBの外部のIC2とも接続 することができる。

【0011】図5は第4の応用例を示す図である。こと では、図4に示した接続構成の装置において、サブモジ ュールBの内部の各IC2とサブ基板3上のIC接続端 子5の間、サブモジュール外部接続端子4とMCM基板 1の間、サブモジュールBの外部のIC2とMCM基板 1の間を、各々ボンディングワイヤ、TAB (TapeAuto mated Bonding) 用リード、あるいはリードフレーム等 (以下では、「ボンデンィングワイヤ」と呼ぶ。) 9で 接続したものである。これにより図4に示した接続を実 現できる。

【0012】図6は第5の応用例を示す図である。とと では、サブモジュールB内の各IC2とサブ基板3上の IC接続端子5'の間を、フリップチップ用リード(球 状半田等) 10で接続し、サブモジュール外部接続端子 4とMCM基板1の間や、MCM基板1とそのMCM基 板1上のIC2との間をボンディングワイヤ9で接続し ている。この構成では、サブ基板3上のIC接続端子 5'がICの直下に配置されるが、図4に示した接続を 実現できる。

【0013】図7は第6の応用例を示す図である。こと では、サブモジュールB内の各IC2とサブ基板3上の IC接続端子5の間、サブモジール外部接続端子4とM CM基板1の間、およびサブモジュールBの外部のIC 2とMCM基板1の間を、ボンディングワイヤ9で接続 50 し、さらにサブモジュールB内の個々のIC2の相互間

もボンディングワイヤタで接続している。この構成でも 図4に示した接続を実現できる。

【0014】図8は第7の応用例を示す図である。ここ では、サブモジュールBの内部のIC2とサブ基板3上 のIC接続端子5の間、サブモジュールBの外部のIC 2とMCM基板1の間をボンディングワイヤ9で接続す ると共に、サブモジュール外部接続端子4°とMCM基 板1の間を、BGA (Ball Grid Array)型リード (球 状半田等) 11で接続している。この構成では、サブ基 板3の裏面にサブモジュール外部接続端子5′が接続さ れる。この構成でも図4に示した接続を実現することが できる。

【0015】[第2の実施の形態]図9は第2の実施の 形態の電子回路装置を示す図である。ここでは、マルチ チップモジュールAに2個のサブモジュールB1、B2 が搭載されている。各サブモジュールB1、B2のサブ モジュール外部接続端子4の相互間を接続することによ り、サブモジュールB1内の1C2を他のサブモジュー ルB2内のIC2と接続することができる。

【0016】この構成では、第1の実施の形態と同様 に、MCM基板1上に必要な配線数が減少し、その歩留 りが向上する。

【0017】図10はその第1の応用例である。ここで は、各サブモジュールB1、B2内の各IC2とサブ基 板3上の I C接続端子5の間、および各サブモジュール B1、B2のサブモジュール外部接続端子4とMCM基 板1の間を、ボンディングワイヤ9で接続している。と れにより、図9の接続を実現できる。

【0018】図11は第2の応用例である。ここでは、 各サブモジュールB1、B2内の各IC2とサブ基板3 上のIC接続端子5の間、および各サブモジュールB 1、B2のサブモジュール外部接続端子4とMCM基板 1の間を、ボンディングワイヤ9で接続している外に、 各サブモジュールB1、B2のサブ基板3のサブモジュ ール外部接続端子4の相互間を直接ボンディングワイヤ 9で接続している。この構成でも図9の接続を実現でき る。

【0019】[第3の実施の形態]図12は第3の実施 の形態の電子回路装置を示す図である。ここでは、サブ 子5の間、およびそのザブ基板3上のサブモジュール外 部接続端子4とMCM基板1の間を、ボンディングワイ ヤ9で接続している外に、サブモジュールB内に第2サ ブモジュールCを内蔵し、この第2サブモジュールC内 の各IC2と第2サブ基板12上のIC接続端子5の間 をボンディングワイヤ9で接続し、さらにこの第2サブ 基板12のサブモジュール外部接続端子4'とサブモジ ュールB内のサブ基板3との間をBGA型リード11で 接続している。この構成では、第2サブモジュールCの 外部接続端子4′が第2サブ基板12の裏面に形成され 50 図、(b)は正面図である。

るが、この構成でも図9の接続を実現することができ る。

【0020】[第4の実施の形態] 図13は第4の実施 の形態の電子回路装置を示す図である。ここでは、サブ モジュールB内のIC2とサブ基板3上のIC接続端子 51 の間をフリップチップ用リード10で接続し、サブ モジュール外部接続端子4とMCM基板1の間、および サブモジュールB外のIC2とMCM基板1との間をボ ンディングワイヤ9で接続する外、サブモジュールB内 10 の I C 2 の上に別の I C 2 を搭載し、その I C 2 と サブモジュールB内のICとの間をフリップチップ用リ ード10で接続している。

【0021】この構成では、2つの10によりサブモジ ュールB内に別のサブモジュール(第2サブモジュール D)が構成されている。サブ基板3上のIC接続端子 5'はIC2の直下に配置され、そのIC2上のIC接 続端子5"は1С2'の直下に配置されるが、図1に示 した接続を実現できる。

【0022】 [その他の実施の形態] 本発明は以上説明 20 した実施の形態に限られるものではなく、例えば次のよ うな形態も実現できる。(1)マルチチップモジュール 内に3個以上のサブモジュールを搭載すること、(2) サブモジュール内に I Cを3個以上搭載すること、

(3) マルチチップモジュール内に複数のサブモジュー ルを搭載すると共に I Cを搭載すること、(4) マルチ チップモジュール内にサブモジュールを搭載すると共に 複数のICを搭載すること、(5)サブモジュール内に 別のサブモジュール(第2サブモジュール)を搭載する こと、(6) I Cは半導体集積回路素子に限られるもの 30 ではなく、ハイブリッドIC、小型実装基板等を用いた 小型モジュールとすること、等である。また、これら以 外にも本発明の概念に基づき様々な構成を実現できる。

【発明の効果】以上のように本発明によれば、マルチチ ップモジュール内部にサブモジュールを搭載するので、 MCM基板やMCMケース等の製造歩留りを向上させる ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態のマルチチップモ モジュールB内の各IC2とサブ基板3上のIC接続端 40 ジュールの構成を示す図で、(a)は平面図、(b)は 正面図である。

> 【図2】 第1の実施の形態の第1の応用例を示すマル チチップモジュールの平面図である。

> 【図3】 第1の実施の形態の第2の応用例を示すマル チチップモジュールの平面図である。

> 【図4】 第1の実施の形態の第3の応用例を示すマル チチップモジュールの平面図である。

> 【図5】 第1の実施の形態の第4の応用例を示すマル チチップモジュールの構成を示す図で、(a)は平面

【図6】 第1の実施の形態の第5の応用例を示すマル チチップモジュールの構成を示す図で、(a)は平面 図、(b)は正面図である。

【図7】 第1の実施の形態の第6の応用例を示すマル チチップモジュールの構成を示す図で、(a)は平面 図、(b)は正面図である。

【図8】 第1の実施の形態の第7の応用例を示すマル チチップモジュールの構成を示す図で、(a)は平面 図、(b)は正面図である。

ジュールの構成を示す図で、(a)は平面図、(b)は 正面図である。

【図10】 第2の実施の形態の第1の応用例を示すマ ルチチップモジュールの構成を示す図で、(a) は平面 図、(b)は正面図である。

【図11】 第2の実施の形態の第2の応用例を示すマ ルチチップモジュールの構成を示す図で、(a)は平面 図、(b)は正面図である。

*【図12】 本発明の第3の実施の形態のマルチチップ モジュールの構成を示す図で、(a)は平面図、(b) は正面図である。

【図13】 本発明の第4の実施の形態のマルチチップ モジュールの構成を示す図で、(a)は平面図、(b) は正面図である。

【図14】 従来のマルチチップモジュールの構成を示 す平面図である。

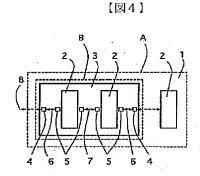
【符号の説明】

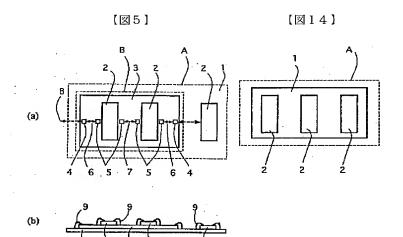
【図9】 本発明の第2の実施の形態のマルチチップモ 10 A:マルチチップモジュール、B:サブモジュール、 C、D:第2サブモジュール

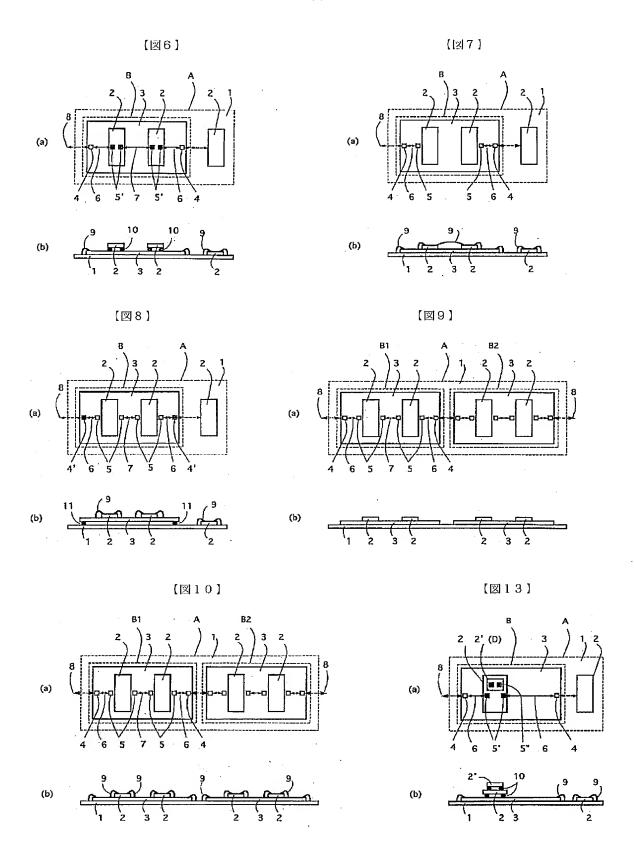
> 1:MCM基板、2、2':IC、3:サブ基板、4、 4': サブモジュール外部接続端子、5、5': IC接 続端子、6:サブ基板内配線、7:サブ基板内配線、

8:MCM外部接続端子、9:ボンディングワイヤ等、 10:フリップチップ用リード、11:BGA型リー ド、12:第2サブ基板。

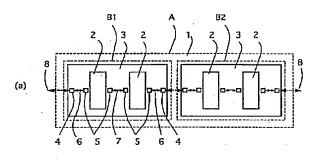
【図3】 [図1] 【図2】 (a) (b)

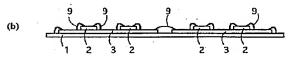




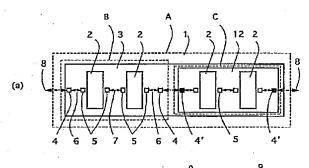


[図11]





[図12]





フロントページの続き

(72)発明者 原田 昭男

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本電信電話株式会社内